



Vpogled v kristalno strukturo materiala s pomočjo ionskih metod

S. Markelj¹, E. Punzón-Quijorna¹, M. Kelemen¹, T. Schwarz-Selinger², X. Jin³, E. Lu³, F. Djurabekova³, K. Nordlund³, J. Zavašnik¹, A. Šestan¹, M. L. Crespillo⁴, G. García López⁴, R. Heller⁵



¹Jožef Stefan Institute (JSI), Ljubljana, Slovenia, ²Max-Planck-Institut für Plasmaphysik (IPP), Garching,

³Department of Physics, University of Helsinki, Helsinki, Finland

⁴Center for Micro Analysis of Materials (CMAM), Madrid, Spain

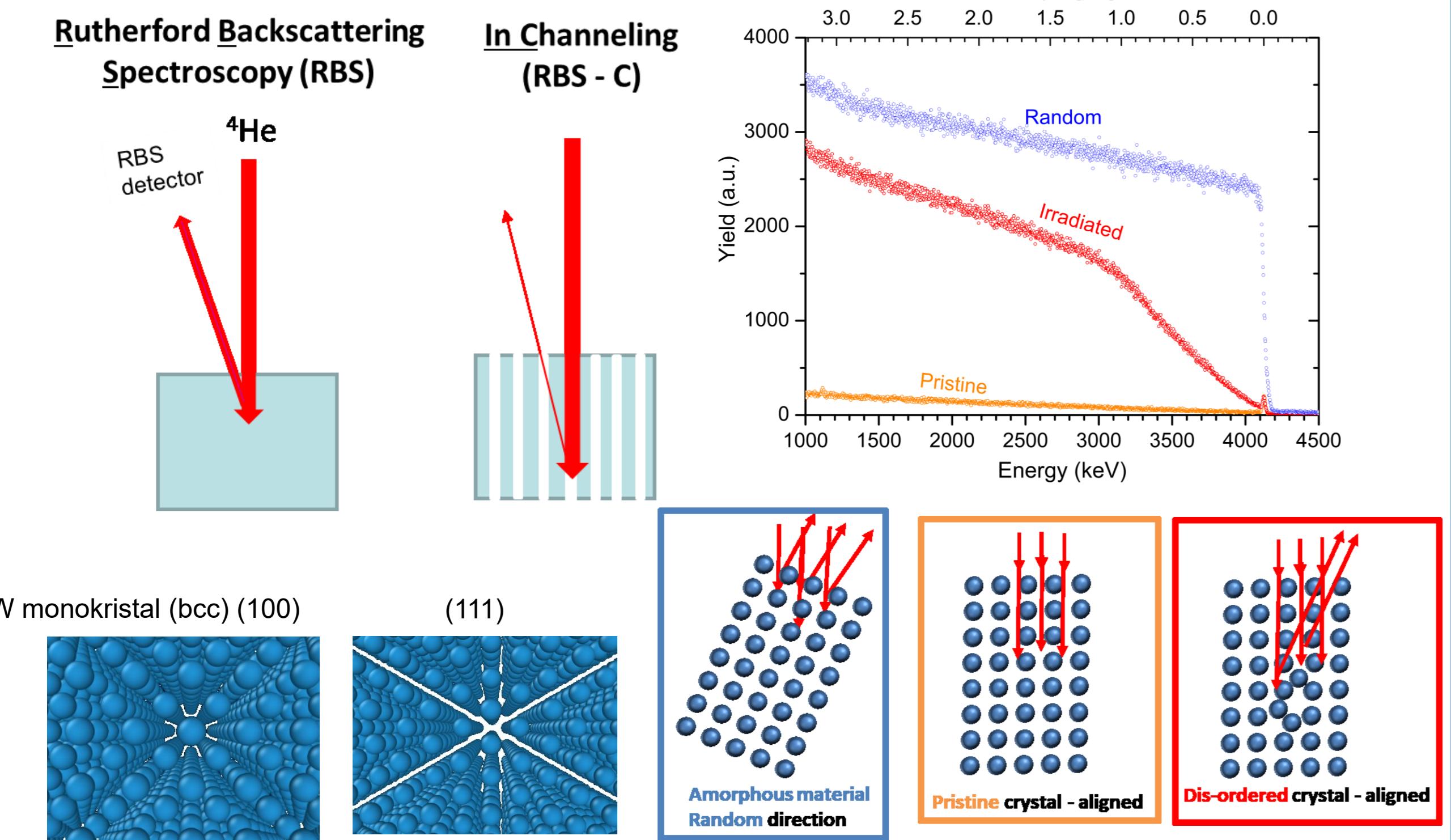
⁵Helmholtz-Zentrum Dresden-Rossendorf (HZDR), Rossendorf, Germany



KONFOR, Poster 41

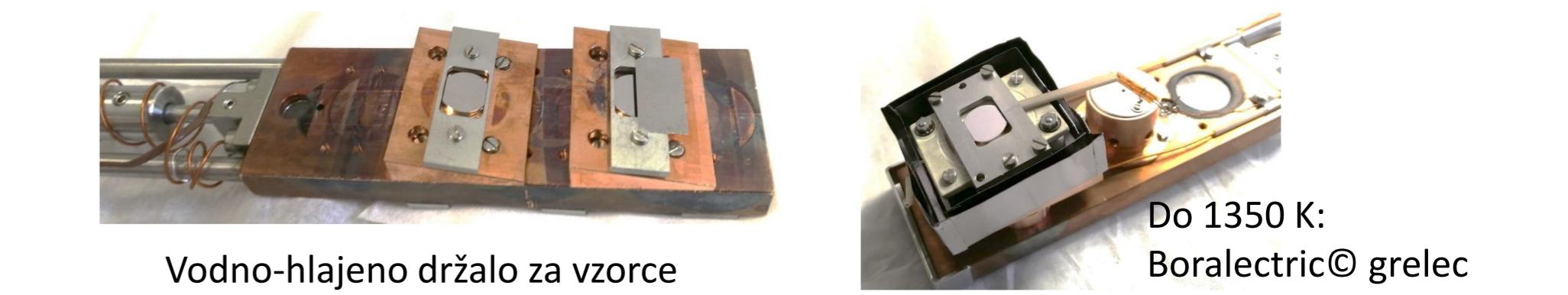
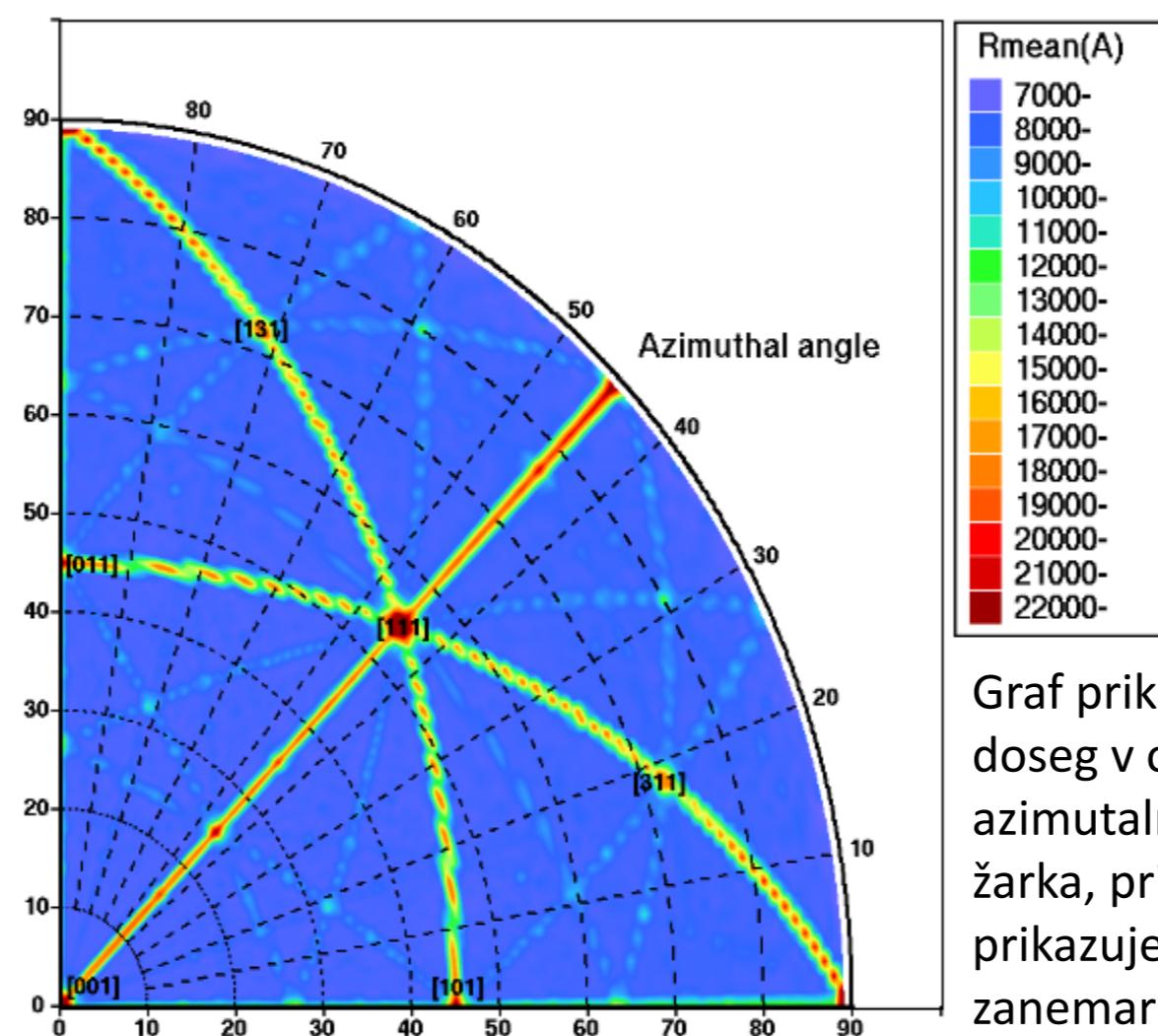
Uvod

Ionska metoda Rutherfordovova spektroskopija povratno sipanih delcev v konfiguraciji kanaliziranja (RBS-C) je dobro uveljavljena metoda za raziskovanje kristalne strukture v monokristalih. Še posebej pa je uporabna za preučevanje napak v kristalni rešetki in razvoja teh napak, ki jih povzroča obstreljevanje z visokoenergijskimi ioni ali nevroni. Za kvantifikacijo napak se meri sprememba v pridelku povratno sipanih lahkih ionov (${}^4\text{He}$) vzdolž določene kristalografske smeri [1].



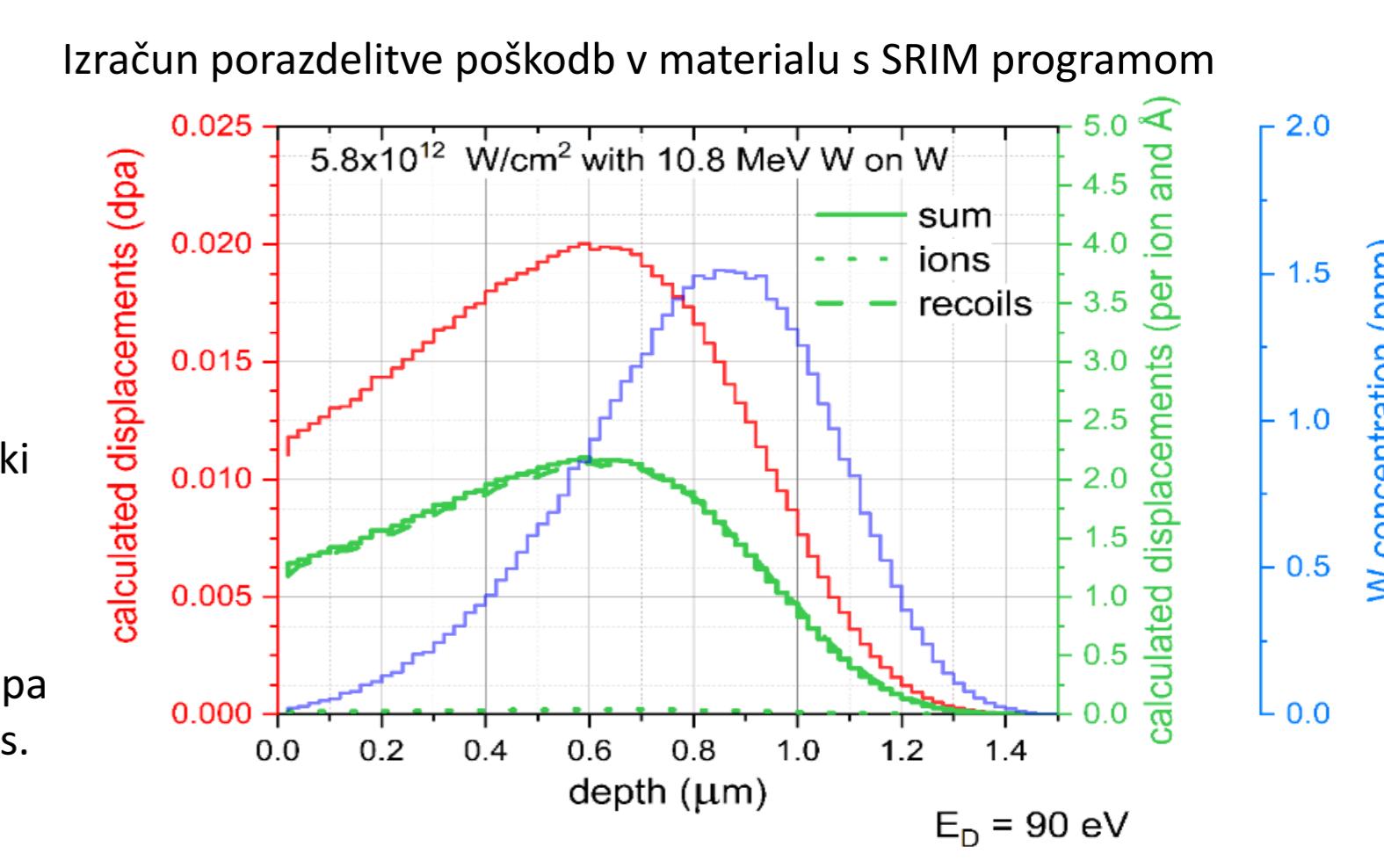
- W (111) in W(100) monokristali (Surface Preparation Laboratory B.V.) polirani in pregreti na 2350 K za 5 min v UHV.
- Defekte smo ustvarili z obstreljevanjem z 10.8 MeV W^{3+} ioni. Vzorec je bil nagnjen za 7° in obrnjen za 11° , da bi se zmanjšalo kanaliziranje.

Povprečen doseg 10 MeV W ionov glede na vpadni kot



Vodno-hlajeno držalo za vzorce

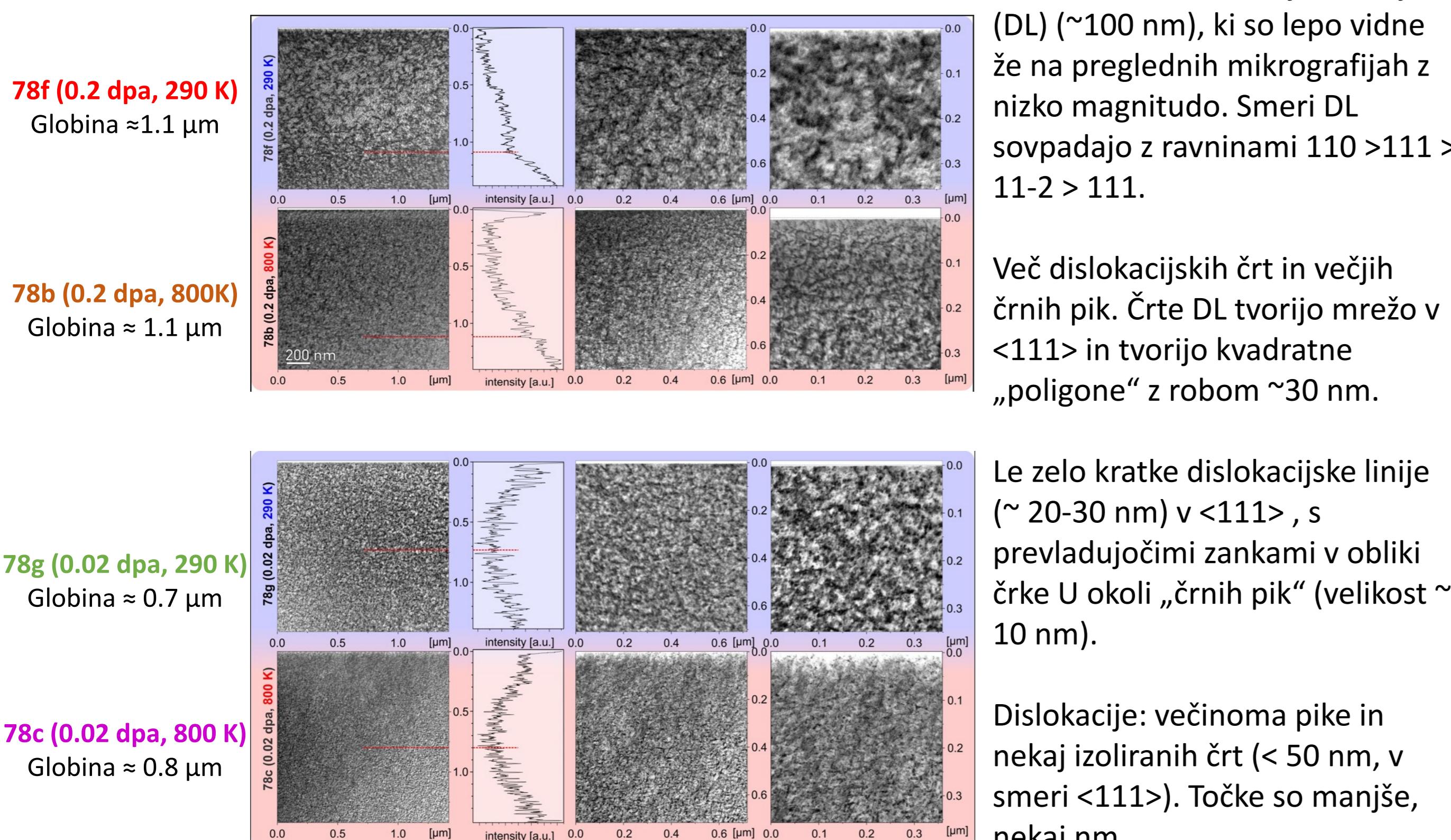
Vzoreci	Pričakovani tip poškodb po [2]
78f	"Zelo poškodovan standard": 0.2 dpa, 290K
78g	"vrzeli": 0.02 dpa, 290 K
78c	"Majhni skupki vrzeli": 0.02 dpa, 800 K
78b	"Veliki skupki vrzeli": 0.2 dpa, 800 K



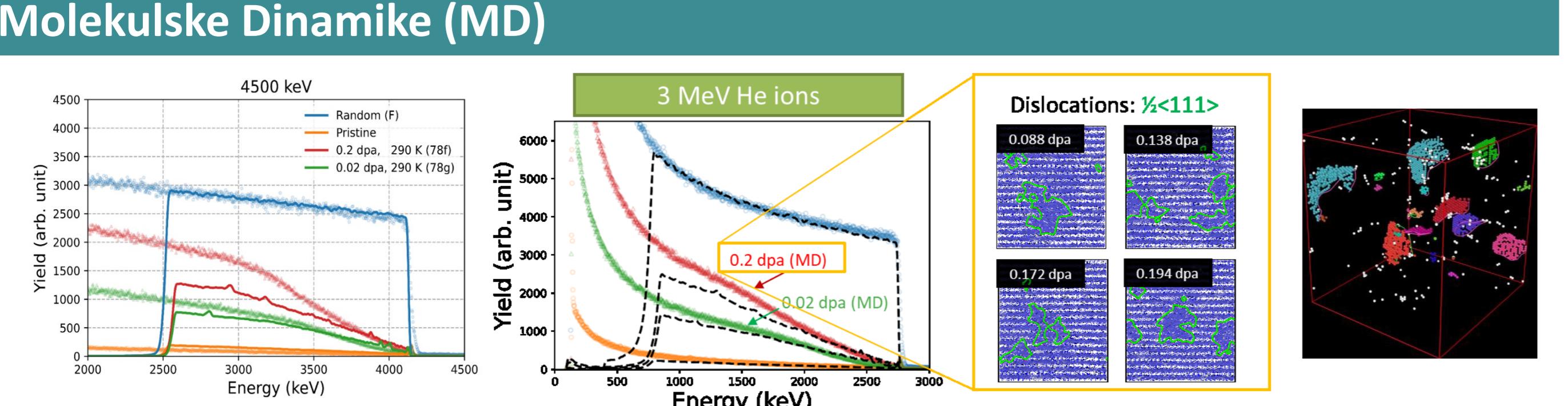
Graf prikazuje povprečni projicirani ionski doseg v odvisnosti od polarnega in azimutalnega vstopnega kota ionskega žarka, pri čemer rdeča in oranžna barva prikazujeta močno kanaliziranje, modra pa zanemarljivo. Izračun je narejen po [Phys. Rev. B 94, 214109 (2016)].

Rezultati

Presevna elektronska mikroskopija (TEM)



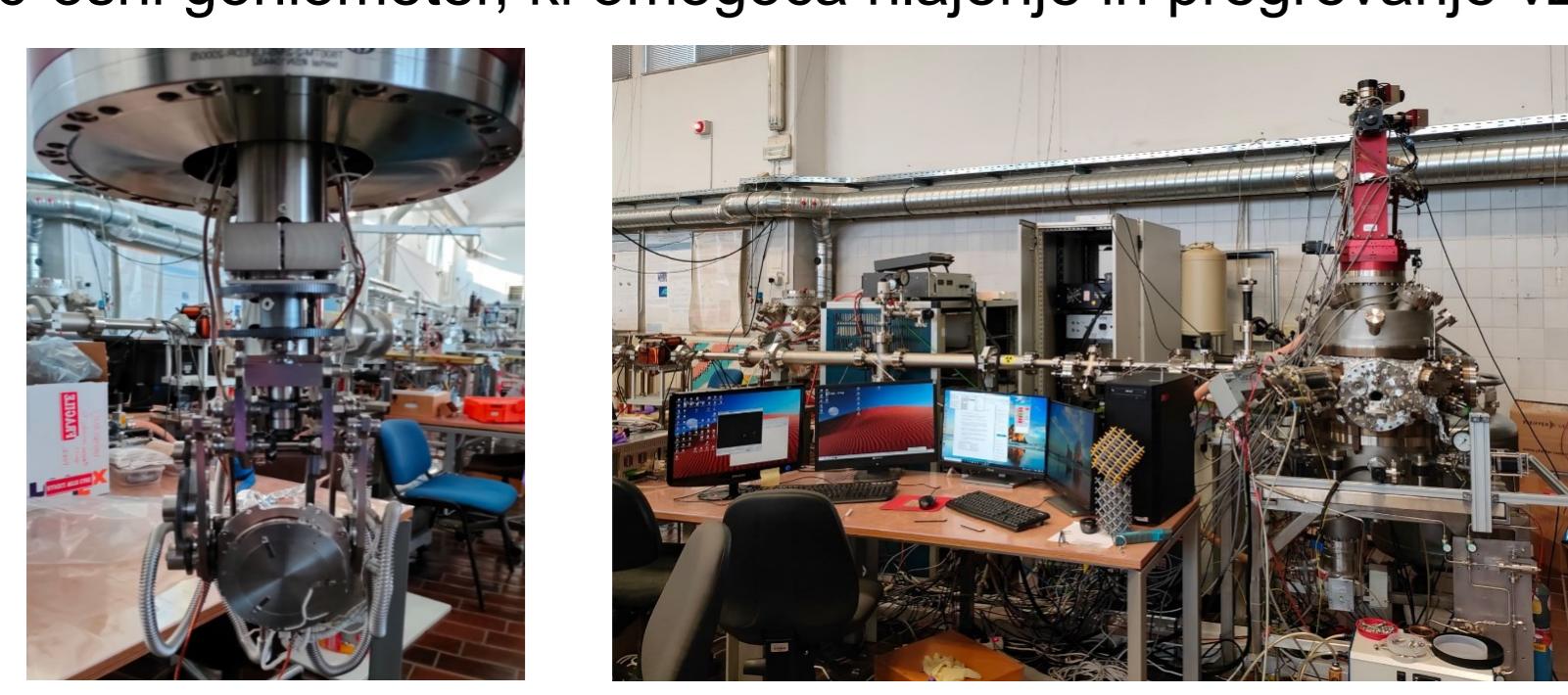
RBSADEC simulacija z vhodno strukturo dobljeno s pomočjo izračunov Molekulske Dinamike (MD)



Eksperimentalne spektre smo tudi simulirali s pomočjo RBSADEC kode [3], kjer smo kot vhodno kristalno strukturo uporabili celice izračunane z molekulsko dinamiko (MD) prekrivajočih se kaskad [Granberg et al. J. Nucl. Mater. 556 (2021) 153158]. Grafa levo prikazuje rezultate simulacij kode RBSADEC [4] (črte) v primerjavi z izmerjenimi spektri RBS-C (točke). Desno so prikazane strukture iz MD celic. Več informacij glej [4].

RBS-C metoda na IJS, F2 pospeševalnik

6-osni goniometer, ki omogoča hlajenje in pregrevanje vzorcev



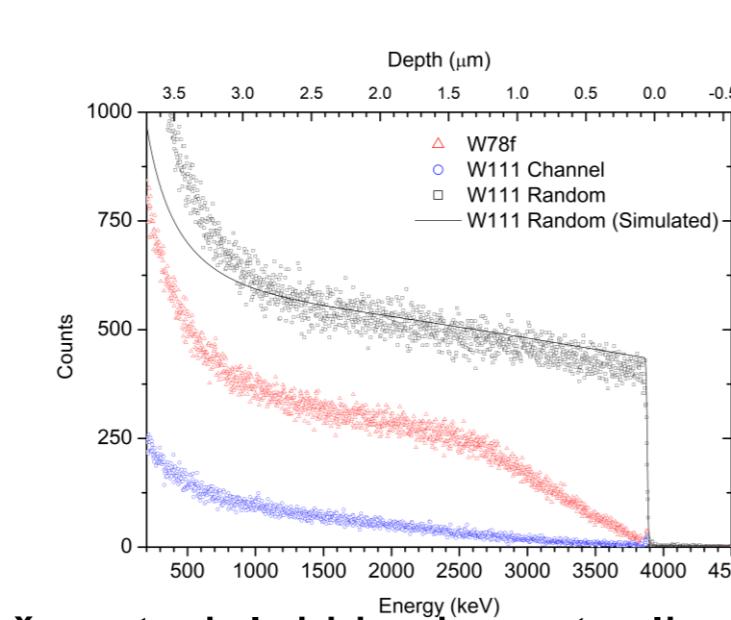
Raziskave potekajo v okviru fizijskih raziskav. Volfram bo nameč material, ki bo izpostavljen plazmi v bodočih fizijskih reaktorjih, vendar pa bo njegova kristalna rešetka v prihodnjem jedrskem okolju močno spremenjena zaradi napak, ki jih bodo povzročili nevroni z energijo 14 MeV, ki izhajajo iz D-T fizijske reakcije. Nastale napake bodo vplivale na fizikalne lastnosti materiala, zato je pomembno da jih razumemo.

Reference

[1] Feldman et al., Academic Press, San Diego, (1982), pp. 88–116.

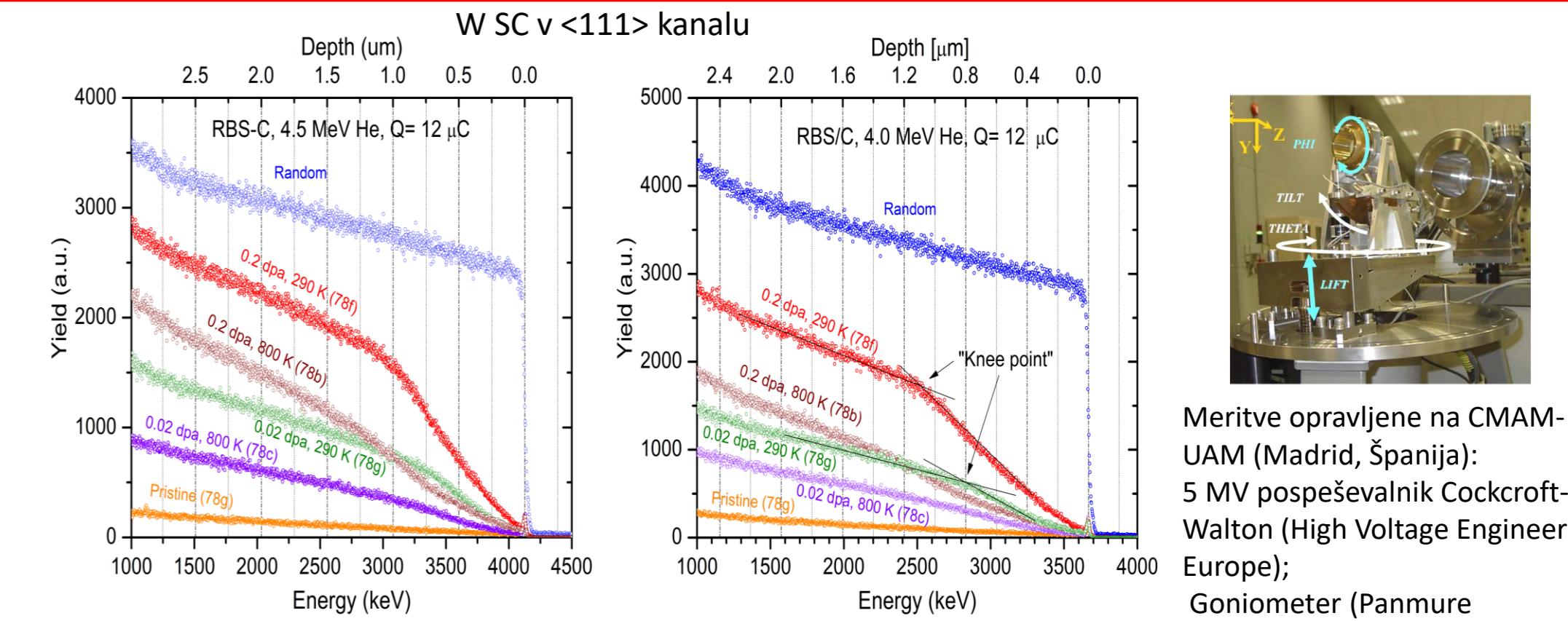
[2] Hu et al., J. Nucl. Mater. 556, (2021) 153175.

Iščemo doktorskega študenta/ko



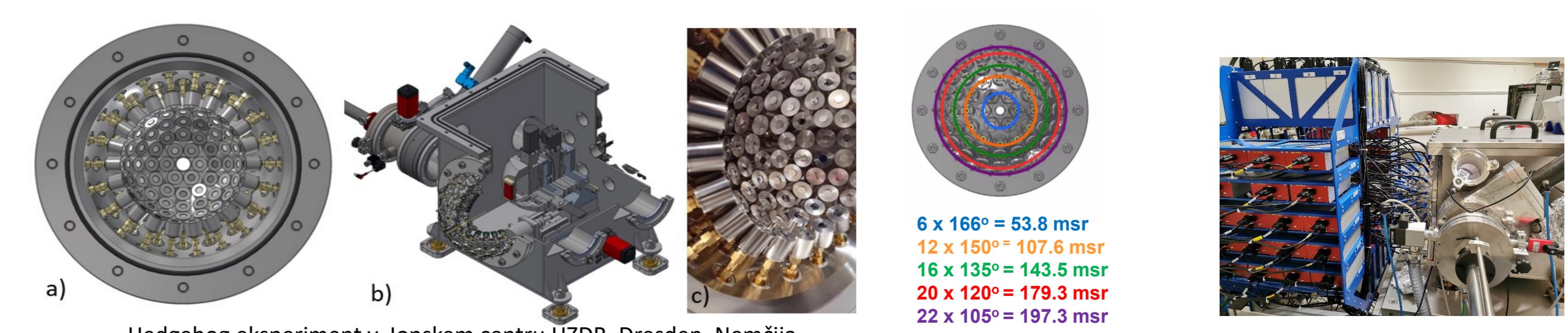
Rutherfordova spektroskopija povratno sipanih delcev v kanaliziranem načinu (RBS-C)

- Multi-energijska RBS-C analiza vzdolž <111> smeri
- Meritev pri štirih energijah ${}^4\text{He}$ žarka: 4.5, 4.0, 3.5, in 3.0 MeV
- W (111) monokristali: Obstreljevani z W ioni.
- Odziv signalov induciranih strukturnih poškodb v odvisnosti od energije primarnega žarka daje pomembne informacije o razširjenosti napak (nepovezane ali razširjene napake) [1,3].



Meritev opravljene na CMAM-UAM (Madrid, Španija): 5 MV pospeševalnik Cockcroft-Walton (High Voltage Engineering Europe); Goniometer (Panurre Instruments, UK)

2D mape RBS-C pridelka merjeni na Hedgehog eksperimentu.

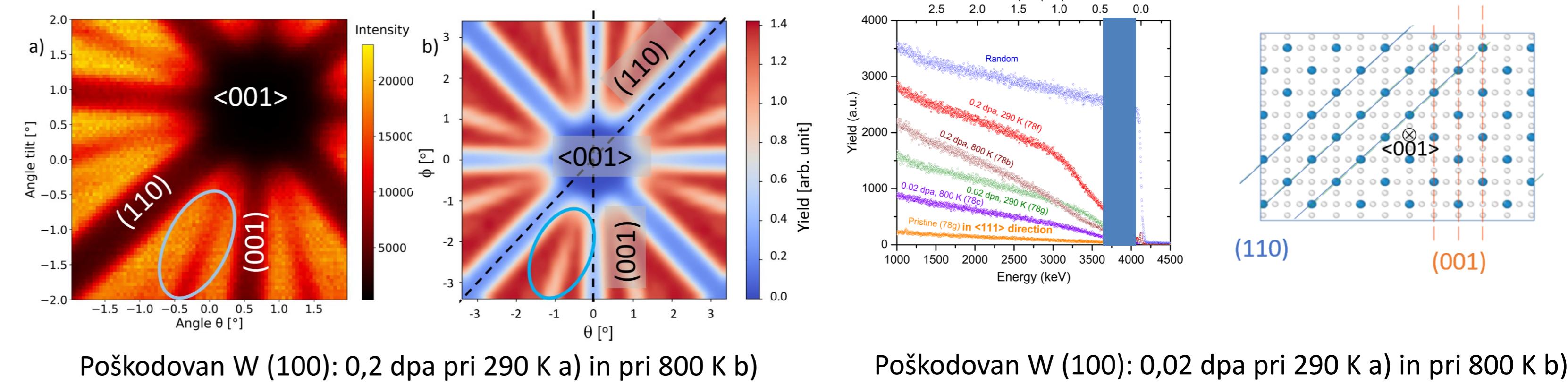


6 x 166° = 53.8 msr
12 x 135° = 107.6 msr
16 x 120° = 143.5 msr
20 x 120° = 179.3 msr
22 x 105° = 197.3 msr

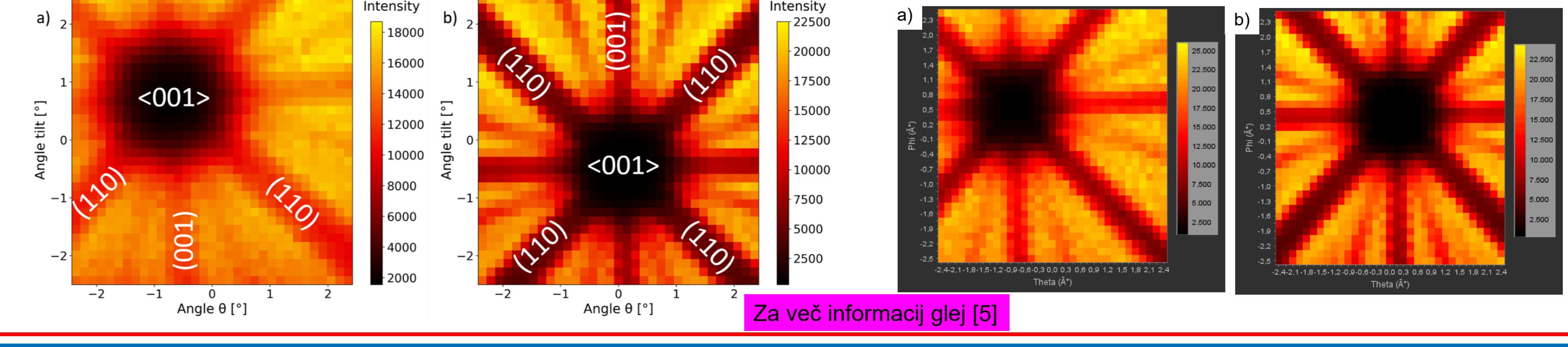
Hedgehog eksperiment v Ionskem centru HZDR, Dresden, Nemčija

W (100) monokristali: Obstreljevani z W ioni.

Izmerjena a) in simulirana b) 2D mapa RBS pridelka v načinu kanaliziranja



Poškodovan W (100): 0,2 dpa pri 290 K a) in pri 800 K b)



Za več informacij glej [5]

Zaključek

Izmerili smo pridelke povratno sipanih ionov v monokristalu volframa W(100) ter jih primerjali s simulacijami in dobili zelo dobro ujemanje. V namen preučevanja napak v kristalni rešetki smo izmerili tudi spektere ter pridelke povratno sipanih ionov v monokristalih W(111) in W(100), ki so bili predhodno obstreljevani z 10,8 MeV ioni volframa pri dveh različnih dozah in temperaturah. Napake povzročene z obstreljevanjem z W ioni smo preučevali s kombinacijo eksperimentalnih in simulacijskih metod. Izkaže se da je metoda primerjave izmerjenih RBS-C spektrov s simuliranimi način, ki omogoča direktno validacijo najnovejših modelov in simulacij.



This work has been carried out within the framework of the EUROfusion Consortium, funded by the European Union via the Euratom Research and Training Programme (Grant Agreement No 101052200 – EUROfusion). Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or the European Commission. Neither the European Union nor the European Commission can be held responsible for them.